

DPAI-HVSDD-Pro 代表高性能的X射线硅漂移探测器，可在极低的成形时间下实现高分辨率。

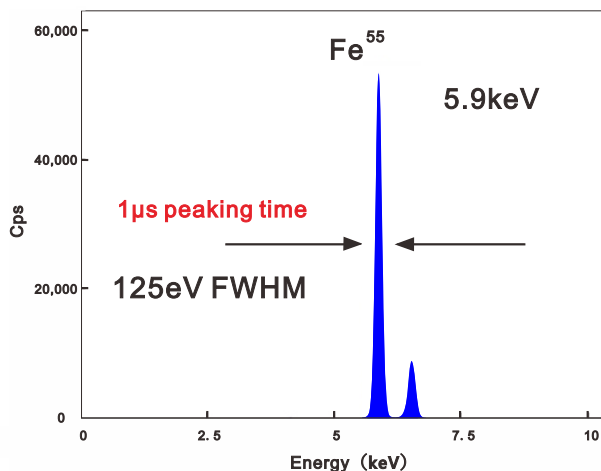
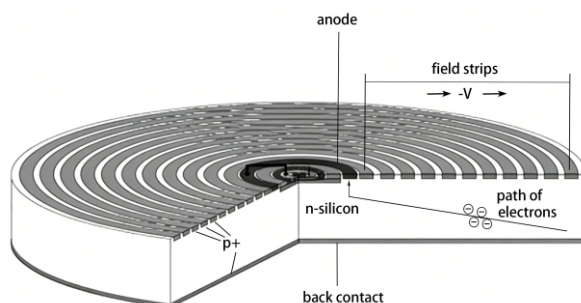
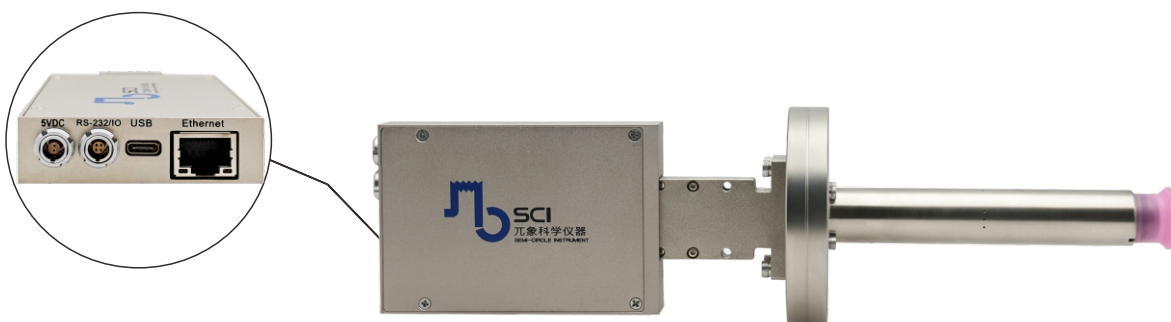


图1: HVSDD数字多道探测器Fe 55光谱图



DPAI-HVSDD-Pro-B



产品描述:

- 125eV FWHM 分辨率 @ 5.9 keV
- 峰背比: 15,000:1
- 感光面积: 20 / 30 / 50mm² × 450 μm
- 最大输入计数率: > 4000KCPS
- 纳秒级复位时间
- 谱图刷新率1000次/秒
- 自锁航空插座
- IP地址、波特率等通讯参数可设置
- 支持3种接口远程固件升级 (无需断电)
- 无需液氮制冷
- USB接口, RS232接口, Ethernet 接口 (1000M可选)
- 极限真空 低于 10⁻⁷ Torr

产品应用:

- X-Ray Fluorescence X射线荧光光谱仪
- RoHS / WEEE Compliance XRF
- OEM 及其特殊应用
- 在线分析检测
- 科研

规格参数概述

类 型	HVSDD-Pro 数字多道探测器
感光面积	20 mm ² / 30mm ² / 50mm ² （可选）
厚 度	450μm
分 辨 率 @5.9keV(Fe55)	125eV FWHM 达峰时间 1μs
峰背比	15000:1
窗口厚度	1μm/8μm (Graphene/Be)
准 直 器	多内层准直器
电荷灵敏度 前置放大器	定制设计，带复位功能。
极限真空	低于 10 ⁻⁷ Torr
重 量	约 568g
电 源	4.5-9VDC
设备生存期	通常 5-10 年，视使用情况而定
保存及运输	常规保存： 温度： -10℃-30℃ 湿度： 10%-90%（非凝结环境下）
工作环境	0℃-50℃

DPAI-HVSDD-Pro能够以极高的能量分辨率实现极高的计数率应用，它的高性能、高密封等特性使其在X荧光光谱分析中得到广泛的应用。

准直器的使用

大多数探测器都装有内部准直器，以提高光谱质量。X射线在探测器有效区域边缘附近相互作用，可能会由于部分电荷收集而产生逃逸峰。

在某些应用中，这些逃逸峰会影响感兴趣信号。内部准直器将X射线限制在产生完整信号的有效区域内。准直器可根据探测器类型改进峰背比（P/B）、消除逃逸峰和改善准直器干扰峰。

附加系统信息和性能

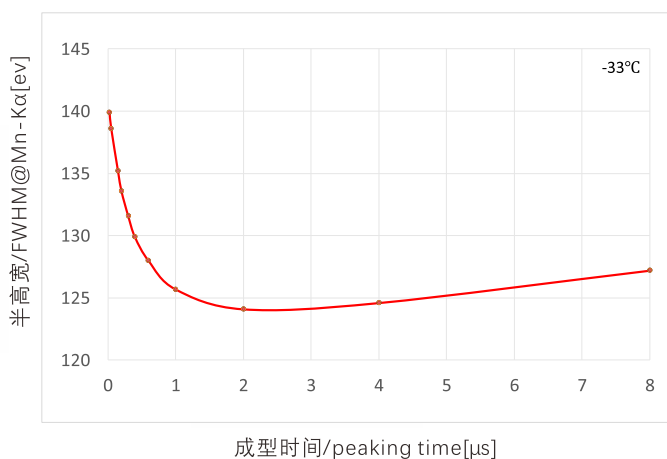


图2.分辨率与达峰时间

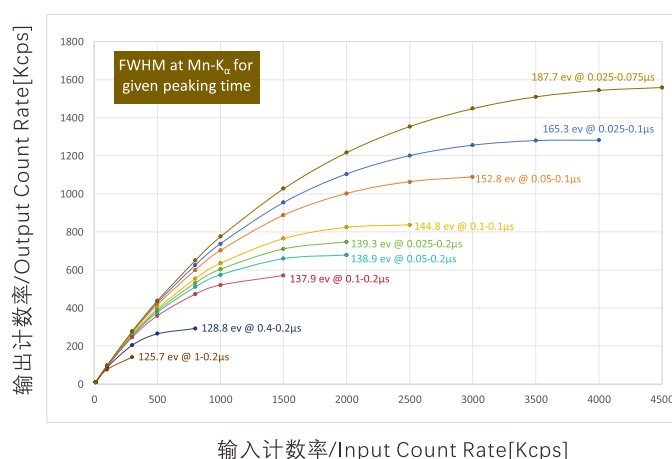


图3.计数通过率/Throughout

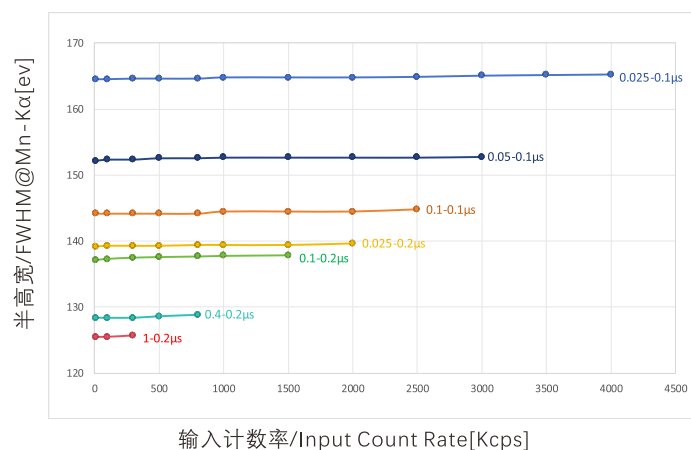


图4.计数率与分辨率

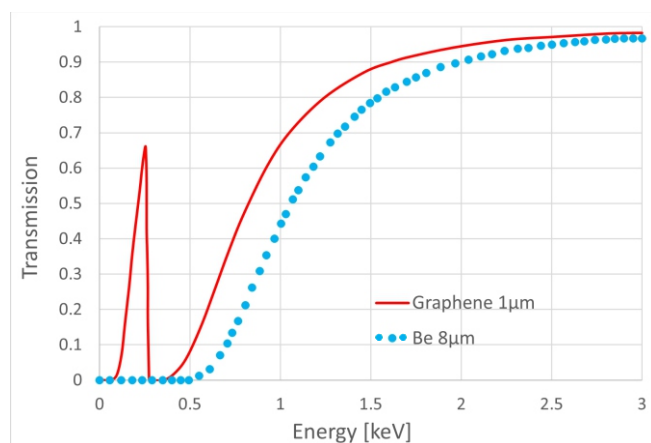


图5.探测器光窗透光率

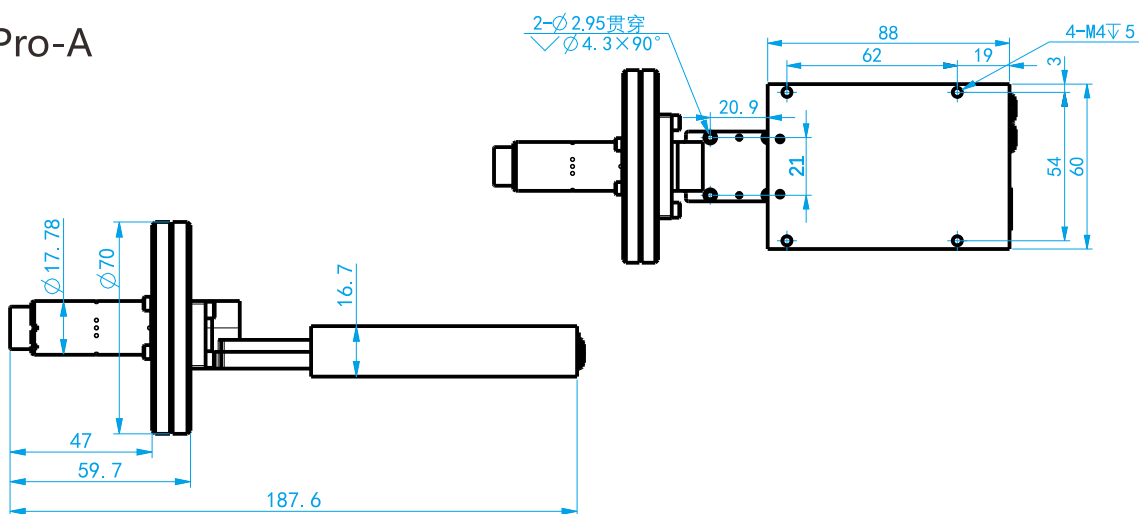
DPAI-HVSDDD-Pro-B法兰尺寸图 (mm)



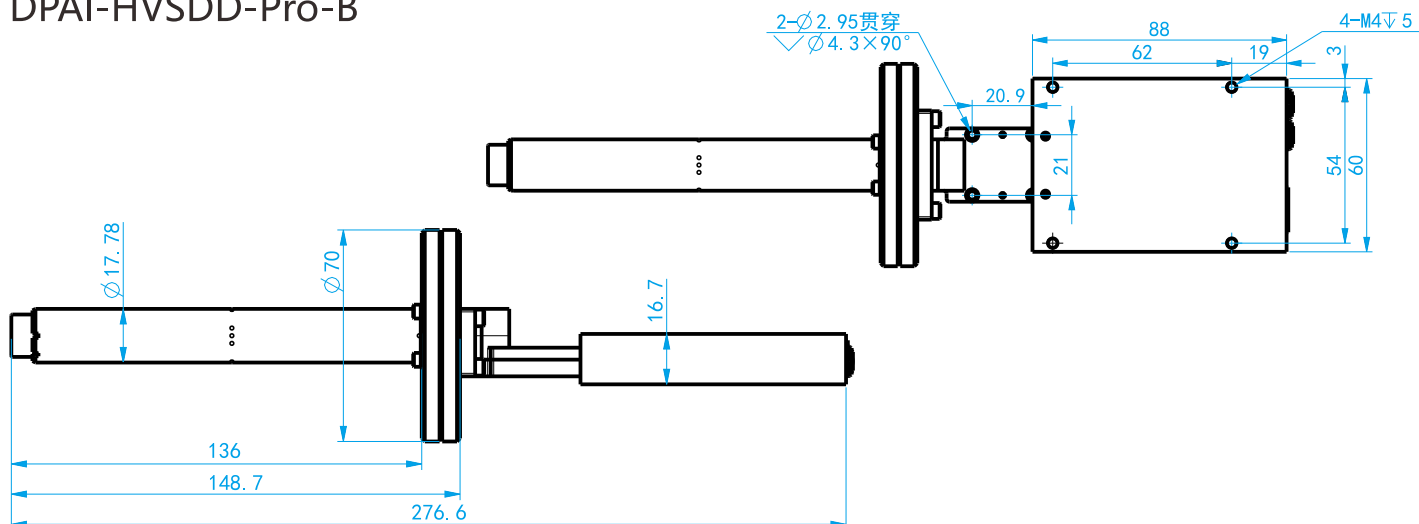
图6. 法兰安装及法兰尺寸图

尺寸图 (mm)

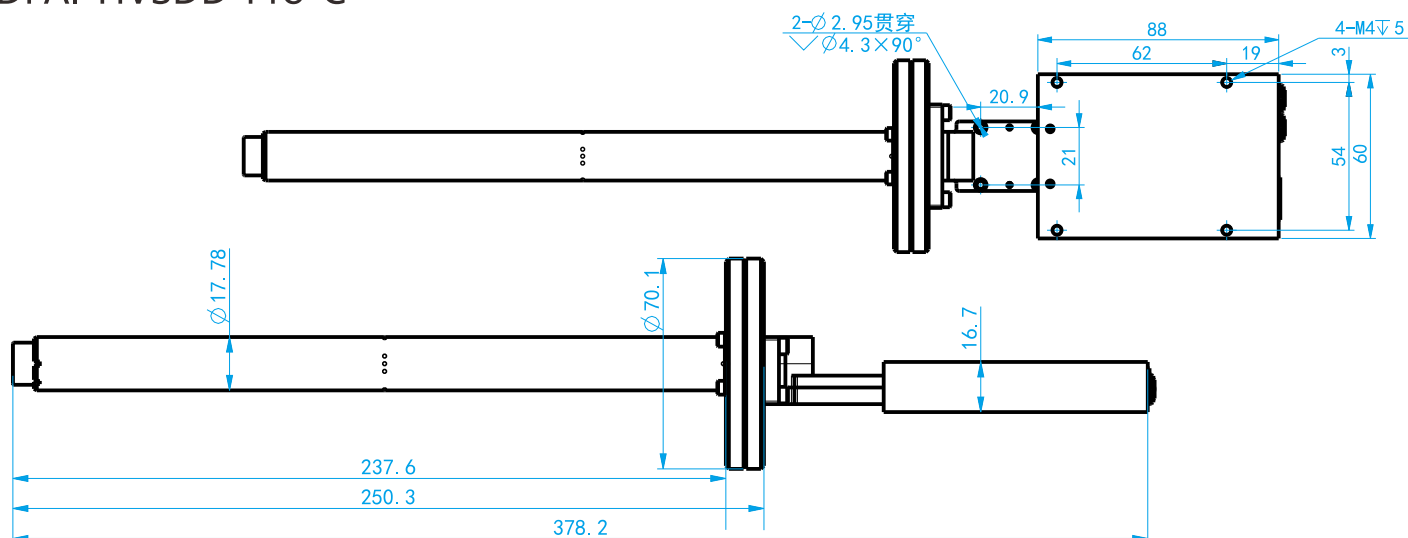
DPAI-HVSDD-Pro-A



DPAI-HVSDD-Pro-B



DPAI-HVSDD-Pro-C



应用谱图

